# 義 ノ ー ト 講

# 平面波基底の第一原理計算法(第二回)

#### 憲\* 山 正 香

(第一回からの続き)

#### 第一原理擬ポテンシャル法の原理 4.

## (1) 固体の電子構造計算の問題点と各種の第一原理計算法

前章(4)節(第一回)の過程③(図4の二重四角)で, 成点毎 にハミルトニアンを組み立て, Kohn-Sham 方程式の固有 値・固有関数を求める部分が「狭義のバンド計算法」である. 本講義で論じる第一原理擬ポテンシャル法も含め、様々な手 法が開発されてきた(1)-(4).本節では全体の様子を論じる.

Kohn-Sham 方程式  $H_{\psi} = E_{\psi}$  において, 波動関数  $\psi$  を互い に規格直交した基底関数系 $\{\phi_i\}(\langle \phi_i | \phi_i \rangle = \int \phi_i^* \phi_i d\bar{r} = \delta_{ij})$ で  $\phi$  $=\Sigma_i C_i \phi_i (\{C_i\} \downarrow k 展開係数) \land k 展開 する \land H\Sigma_i C_i \phi_i =$  $E \Sigma_i C_i \phi_i$ である. 左から〈 $\phi_i$  | を作用させると  $\Sigma_i \langle \phi_i | H | \phi_i \rangle C_i$ =  $EC_i$ (注:  $\langle \phi_i | H | \phi_i \rangle = \int \phi_i^* H \phi_i d\bar{r}$ )で, エルミート行列  $[H]_{ij} = \langle \phi_i | H | \phi_j \rangle$ について $H\vec{C} = E\vec{C}$ の固有値E,固有ベク トル $\vec{C}(\{C_i\})$ を求める問題になる.基底関数系が直交化して いない場合,重なり行列[S]<sub>ij</sub>=〈 $\phi_i | \phi_j$ 〉を含む  $H\vec{C} = ES\vec{C}$ の 固有値問題となる. 適当な数で高精度に電子の波動関数が表 現できる基底関数系が望ましい. なお, 基底関数自体がブロ ッホの定理(前章式(17))を満たす必要があり、 $H\vec{C} = E\vec{C}$ の 固有値方程式は k 点毎に組み立てられる.

固体中の電子構造計算は、この基底関数の構築で困難が存 在する. その要因は, 原子核近傍の極めて深いポテンシャル 場と原子間領域の比較的平坦なポテンシャル場の両方の存在 である(図5(a)). 原子核近傍に着目すれば, ①深い球対称 場の解である原子軌道様関数の基底関数が考えられる.結晶 中の繋がった原子間の平坦場に着目すれば、2)自由電子的な 広がった平面波の基底関数を用いることが考えられる. ①の 方法では原子間領域の表現に難点があり,②の方法では原子 核近傍の表現に難点がある.図5(a)に示すように、価電子



(a) 固体(結晶)中の全電子ポテンシャル VAE と固有状 図 5 態の波動関数(内殻軌道 $\phi_{c1}, \phi_{c2},$ 価電子バンド $\phi_v$ )の概 念図. 図の上下方向はポテンシャルと各固有エネルギー のエネルギー軸での位置を示し、左右方向は原子の並び でのポテンシャルや波動関数の空間変化を示す. 破線は 各原子から半径r<sub>c</sub>の領域. 波動関数は, ブロッホ関数  $\psi_{kn}(\bar{r}) = e^{i\bar{k}\cdot\bar{r}} U_{kn}(\bar{r}) \mathcal{O} U_{kn}(\bar{r}) \mathcal{O}$ 部分を示す(図3参 照).一般に複素数であるが、単純化して示す.価電子 波動関数  $\phi_n$  は内殻軌道との直交化の要請  $\int \phi_n^*(\bar{r}) \phi_c(\bar{r})$  $d\bar{r}=0$ のため、半径 $r_c$ 内で振動する(ノードを持つ). (b) 半径 r<sub>c</sub>内を底上げした「擬ポテンシャル」により, 価電子波動関数 ψ から原子核近傍の振動を取り除く. 半径 r<sub>c</sub> 外は正しい価電子波動関数,全電子ポテンシャ ルを再現させる.

<sup>\*</sup> 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 エネルギー・環境領域 電池技術研究部門;名誉リサーチャー(〒563-8577 池田市緑が丘1-8-31 産総研関西センター)

Lecture Notes on First-Principles Methods Using a Plane-Wave Basis Set (Part 2); Masanori Kohyama\*(\*Research Institute of Electrochemical Energy, Department of Energy and Environment, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, Ikeda) Keywords: norm-conserving pseudopotential method, all-electron atomic orbital calculation, local pseudopotential, non-local pseudopotential, ultrasoft pseudopotential method, projector augmented wave method 2022年1月11日受理[doi:10.2320/materia.61.679]

の波動関数  $\phi_v$  は原子間領域ではスムーズだが,原子核近傍 では内殻軌道  $\phi_c$  との直交化  $\int \phi_v^*(\bar{r}) \phi_c(\bar{r}) d\bar{r} = 0$ の要請のた め,振動が不可避で,そのままでは平面波基底での展開に適 さない.局所的に大きく変化する波動関数を平面波基底で表 すには,短い波長の多数の平面波が必要になり,計算のサイ ズが巨大になる(第5章(2)節参照).一方,両者の間をとり, ③原子核近傍では原子軌道様(球面波展開)で,原子間領域で それを平面波に繋ぐ基底関数の構築も考案されている.

第一原理バンド計算法は、①の系統の手法として、第一原 理 LCAO (linear combination of atomic orbitals)法(混合基底 法含む)<sup>(23)</sup>、③の系統の手法として、線形化法<sup>(24)</sup> (FLAPW (full-potential linearized augmented plane wave)法<sup>(25)</sup>、FP-LMTO (full-potential linear muffin-tin orbital)法など)、② の系統の手法として、平面波基底を用いる第一原理擬ポテン シャル法(ノルム保存擬ポテンシャル(norm-conserving pseudopotential; NCPP)法<sup>(26)(27)</sup>、ウルトラソフト擬ポテン シャル (ultrasoft pseudopotential; USPP)法<sup>(28)</sup>、PAW (projector augmented wave)法<sup>(29)(30)</sup>)が開発されている。 ③の分類の手法が最も高精度だが、内殻軌道から価電子バン ドまで全電子を扱うので(全電子法とも呼ばれる)、計算負荷 が大きいのが弱点である.

## (2) 擬ポテンシャルの考え方

本講義では、②の分類の手法を扱う.価電子バンドのみを 平面波基底で扱い、内殻軌道は自由原子(孤立原子)と同様の ものが存在するとする.平面波基底を用いることで、波動関 数や電子密度分布、ハミルトニアン、全エネルギーの取り扱 いが効率化され、大規模固有値計算の高速化技法(第7章) と組み合わせることで、大規模構造や第一原理分子動力学法 の計算が可能となる.第一原理擬ポテンシャル法と総称する が、ノルム保存擬ポテンシャル法、ウルトラソフト擬ポテン シャル法、PAW 法の順に開発され、効率と精度が向上して きた.現在は PAW 法の使用が多いが、共通する基本概念・ 原理はノルム保存擬ポテンシャル法で確立されたので、それ を中心に説明し、発展として後二者も紹介する.

前節で触れた価電子波動関数の原子核近傍の振動をどう扱うかが本手法の鍵である.図5(a)の固体中の電子構造について,全電子(内殻電子,価電子を区別しない)に密度汎関数理論を適用した式(5)のSCFの全電子ポテンシャル $V_{\text{eff}}(\bar{r})$  =  $V(\bar{r}) + V_H(\bar{r}) + \mu_{xc}(\bar{r})$ は,全電子に共通で, $V(\bar{r})$ が裸の原子核のクーロン場, $V_H(\bar{r}) + \mu_{xc}(\bar{r})$ が内殻電子と価電子による静電ポテンシャルと交換相関ポテンシャルである.全電子ポテンシャルを強調する意味で,今後, $V_{\text{AE}}(\bar{r})$ と表記する(AE tall electronの意).各原子で内殻軌道の波動関数が存在する領域の内と外をカットオフ半径 $r_c$ で分けると,原子核近傍の $r_c$ 内で $V_{\text{AE}}(\bar{r})$ は自由原子と同様の深い球対称場で,自由原子と同様の内殻軌道が結晶でも低い準位の固有状態となる(図5(a)の $\phi_{c1}$ , $\phi_{c2}$ ).内殻軌道は原子間結合には直接には寄与しない.また,他原子の原子核のクーロン場は

領域には価電子しかないので、そこの  $V_{AE}(\bar{r})$ は、実質、価 電子の感じるポテンシャルで、内殻電子で遮蔽された  $V(\bar{r})$ (正イオンのクーロン場)と内外の価電子による  $V_H(\bar{r})$  +  $\mu_{xc}(\bar{r})$ である.

価電子バンドの波動関数(図 5(a)の $\phi_v$ )は $r_c$ 外でスムーズ に変化し、平面波基底展開に適するが、上述のように $r_c$ 内 では内殻軌道と直交するために振動する(ノードを持つ).波 動関数 $\phi_v$ の $r_c$ 内の振動は、波動関数が感じる深いポテンシ ャル  $V_{AE}(\bar{r})$ を(振動による)運動エネルギー上昇で補い、内 殻準位より高い固有エネルギーを保つ意味もある.式(4) から固有エネルギーは $\varepsilon_v = \int \phi_v^*(\bar{r}) H \phi_v(\bar{r}) d\bar{r} = \int \phi_v^*(\bar{r}) (-\hbar^2/2m\nabla^2) \phi_v(\bar{r}) d\bar{r} + \int \phi_v^*(\bar{r}) V_{AE}(\bar{r}) \phi_v(\bar{r}) d\bar{r}$ で、運動エネルギー 演算子  $-\hbar^2/2m\nabla^2$ から、波動関数は空間変動が大きいほど 高運動エネルギーである.

 $r_c$ 球内の深いポテンシャルと内殻軌道の存在が振動の起源 なので、電子構造計算から内殻軌道を除外し、価電子だけを 対象に、 $r_c$ 内で底が浅くなり、 $r_c$ 外では正しい全電子ポテン シャル $V_{AE}(\bar{r})$ になる「人工的ポテンシャル」での密度汎関 数理論の実行を考える(図 5(b)).実際、(a) $r_c$ 内を底上げす れば、スムーズで振動せず、原子間に広がった価電子の波動 関数を生み、(b)価電子の波動関数の $|\phi_v|^2$ の積分(ノルム)が 各原子の $r_c$ 内で正しく保たれるようにすれば、 $r_c$ 外で正し い全電子ポテンシャル $V_{AE}(\bar{r})$ になるはず.そうすると(c) $r_c$ 外で全電子計算による価電子の正しい波動関数を再現し、 (d) $r_c$ 内のポテンシャルの底上げと波動関数の振動の消失が 相殺して、固有エネルギーも正しく再現される可能性がある.

こういう要請を満たす原子毎のポテンシャル構築は後述の ように可能で、「擬ポテンシャル(pseudopotential)」と呼ば れる.式(5)の原子核のクーロン場の和である  $V(\bar{r})$ の代わ りに各原子の擬ポテンシャルの和  $V_{PS}(\bar{r})$ を用いて(PS は pseudoの意味)、その下での価電子系についてだけの密度汎 関数理論計算(Kohn-Sham 方程式)を有効ポテンシャル

 $V_{\text{eff}}(\bar{r}) = V_{\text{PS}}(\bar{r}) + V_{H}(\bar{r}) + \mu_{\text{xc}}(\bar{r})$ (26) を用いて実行するのである.  $V_{H}(\bar{r}) \ge \mu_{\text{xc}}(\bar{r})$ は擬ポテンシャ ルの下での価電子分布による静電ポテンシャルと交換相関ポ テンシャルである.  $V_{\text{PS}}(\bar{r})$ は, 周期系の $\bar{R}$ の全単位胞の全 原子(内部座標 $\bar{t}_{a}$ )の擬ポテンシャル  $V_{a}^{\text{PS}}$ の総和で,

$$V_{\rm PS}(\vec{r}) = \sum_{\vec{p}} \sum_{a} V_a^{\rm PS}(\vec{r} - \vec{t}_a - \vec{R})$$
(27)

である.  $V_{a}^{PS}$ は、原子種 a 毎に予め組み立てられ、価電子の みに作用する.  $r_c$ 内では底上げされた形で、 $r_c$ 外では原子 から価電子を除いた正イオンのクーロン場になる. こうして 式(26)のポテンシャル場で、価電子波動関数は $r_c$ の内でも 外でも振動(ノード)を持たず(図5(b))、平面波基底展開が 可能となる.式(26)は、原子間領域では正イオンのクーロ ン場と価電子による $V_H(\bar{r}) + \mu_{xc}(\bar{r})$ である. 上述のように価 電子波動関数のノルムが各原子の $r_c$ 球内で全電子計算の正 しいものに保たれれば、このポテンシャルは原子間領域で  $V_{AE}(\bar{r})$ に等しくなると考えられる. 後述のようにノルム保 存条件は本質的に重要である. 擬ポテンシャルの擬(pseudo)は「偽」という意味.計算 される価電子の波動関数は, $r_c$ 外の原子間領域では正しい が, $r_c$ 内ではノードが取り除かれ正しくないので(図5 (b)),擬波動関数(pseudo wave function)と呼ばれる.磁性 など精度の落ちる物理量もあるが,凝集エネルギーや安定原 子配列など, $r_c$ 外の価電子挙動や原子間結合が支配する物理 量は,高精度に求まるはずである.

# (3) 第一原理擬ポテンシャルの組み立て法(その1):自由 原子の全電子計算

1979年に Hamann らは、上記の要請を満たす第一原理擬 ポテンシャル(ノルム保存擬ポテンシャル)が、元素毎に構築 できることを示した<sup>(26)(27)</sup>.本節と次節で説明する.

まず,自由原子(孤立原子)の全電子計算(内殻電子と価電 子の全原子軌道計算)で,原子の全電子ポテンシャル $V_{AE}(\bar{r})$ と原子軌道の波動関数を求めることから始める.詳細は例え ば文献(31)(32)参照(文献(27)(33)にも情報がある).自由 原子では,Kohn-Sham 方程式のポテンシャル $V_{AE}(\bar{r})$ が球 対称場のため,変数分離により動径成分と方位座標成分の方 程式に分けて解かれる.式(4)の $\nabla^2$ の球座標表示( $r, \theta, \phi$ ) から以下のようになる.

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dr^2}rR_{nl}(r) + \left\{\frac{\hbar^2 l(l+1)}{2mr^2} + V_{\rm AE}(r)\right\}rR_{nl}(r) = \varepsilon_{nl}rR_{nl}(r)$$
(28)

$$\begin{cases} \frac{1}{\sin\theta} \frac{\partial}{\partial\theta} \left( \sin\theta \frac{\partial}{\partial\theta} \right) + \frac{1}{\sin^2\theta} \frac{\partial^2}{\partial\phi^2} \end{cases} Y_{lm}(\theta, \phi) \\ = -l(l+1) Y_{lm}(\theta, \phi) \tag{29}$$

 $\varepsilon_{nl}$ は固有エネルギー(原子準位), $V_{AE}(\vec{r})$ は $V_{AE}(r)$ として 共に動径方程式(28)にのみ入る.原子核近傍の深いポテン シャル場で電子が高速になるので,式(28)は実際には相対 論効果を取り入れた形(scalar relativistic 等)を用いる.簡単 のためそれを除いた非相対論形を表示している(後述の価電 子軌道や擬ポテンシャルの構築は,この表式でよい).式 (29)の解は球面調和関数 $Y_{lm}(\theta,\phi)$ である.式(28)の解の動 径波動関数 $R_{nl}(r)$ と $Y_{lm}(\theta,\phi)$ の積 $R_{nl}(r)Y_{lm}(\theta,\phi)$ が求める 原子軌道の波動関数である $(R_{nl}(r)$ は実関数).nは主量子数  $(n=1,2,3\cdots),l$ は軌道角運動量量子数 $(l=0\sim n-1),m$ は磁気量子数 $(m=-l\sim+l)$ .l=0, 1, 2 が s, p, d 軌道に 対応する.磁気量子数mと式(28)中の電子質量mとの区別 に注意.

方位座標成分の解 $Y_{lm}(\theta, \phi)$ は自明なので、専ら球対称場  $V_{AE}(r)$ の式(28)の動径方程式(常微分方程式)をn, l毎に解 く(固定したlにつき、下の準位から順にn がl+1から増え る). 原点(原子核位置)からr座標の細かいメッシュ(原子に 近いほど細かい対数メッシュ)を刻み、 $rR_{nl}(r)$ を求める関数 として、r=0から遠方にメッシュ点毎の $rR_{nl}(r)$ の値を(予 測子修正子法を用いて)逐次繰り返し法で解く(実際には座標 変換でrの対数メッシュを等間隔メッシュの微分方程式に替 えて解く). 下の準位と直交するよう $rR_{nl}(r)$ を解き(後述式 (30)参照)、無限遠からも解き、繋がる条件から $\varepsilon_{nl}$ を決め



図6 (a) 自由原子の全電子計算による動径波動関数  $R_{nl}(r)$ .  $l=0, n=1\sim3(1s\sim3s 軌道) の rR_{nl}(r) の様子の概念図$ を示す. 全電子に密度汎関数理論を適用した結果で, $<math>V_{AE}$  が SCF の全電子ポテンシャル. nが増えるほど下 の準位との直交化の要請(式(30))で, ノード(r=0 以外 で r $R_{nl}(r)=0$  になる地点)が増える. (b) 最外殻の 3s 軌道関数からの s(l=0)成分の擬ポテ ンシャル構築の概念図. 3s 軌道について, 半径  $r_c$ 以遠 で  $rR_{3s}^{PS}(r) = rR_{3s}(r), V_{a,s}(r) = V_{AE}(r)$ の条件のもと, ノルム  $\int r |rR_{ns}^{PS}(r)|^{2} dr$ を保存し, ノードを持たず, 且 つ正しい固有エネルギーを持つ  $rR_{3s}^{SS}(r)$ を式(31)で出力 するように, ポテンシャル  $V_{a,s}(r)$ を  $0 \le r \le r_c$ の領域で 人工的に構築する.

る. ポテンシャル場は,原子核のクーロン場と適当な電子密 度分布からの初期  $V_{AE}(r)$ から始めて式(28)を解き,占有準 位から  $V_{AE}(r)$ 内の  $V_{H}(r)$ ,  $\mu_{xc}(r)$ を更新,再び式(28)を解 き,SCF 計算が収束するまで繰り返す.最終的に  $V_{AE}(r)$ ,  $R_{nl}(r)$ ,  $\epsilon_{nl}$ のセットが求まる(動径波動関数は $R_{nl}(r)$ だが, 数値データは  $rR_{nl}(r)$ で扱う).

図 6 (a)に l=0,  $n=1\sim3(1s\sim3s$  軌道)の動径波動関数の 例を示す. 原点以外で  $rR_{nl}(r)=0$  となる  $r \leq (rR_{nl}(r)$ の正負 が変わる地点)をノードという. ノードは,原子波動関数間 の直交化条件( $Y_{lm}(\theta, \phi)$ が共通で異なる n の動径波動関数間 の直交化条件,次式)に起因する.

$$\int_{0}^{\infty} R_{nl}(r) R_{n'l}(r) r^2 dr = \delta_{nn'}$$
(30)

積分に  $r^2$  が入るのは極座標での積分の  $d\bar{r} = r^2 \sin \theta \, drd \, \theta \, d\phi$ の関係による.  $R_{nl}(r)$ は実関数で,全領域で正の 1s 軌道(n = 1, l=0)の  $rR_{1s}(r)$ に対し,式(30)の要請で 2s 軌道(n=2, l=0)の  $rR_{2s}(r)$ はノードが一つで正負に変わる必要がある.  $rR_{3s}(r)$ はノードが二つで,ノード数は n-l-1で増える. 同様に 2p~4p 軌道, 3d~5d 軌道でも  $rR_{nl}(r)$ のノード数が 0 から順に増える. nの大きい上の準位ほどノードが増える のは,前節の議論のように運動エネルギーの上昇から当然で ある. また,原子核からの電場の遮蔽の点から上の準位ほど | $rR_{nl}(r)$ |の最大点  $r_{max}$ は遠方になる.

こうした原子の価電子軌道の内殻軌道との直交化のための ノードは、固体(結晶)での価電子波動関数の原子核近傍での 振動(ノード、図 5(a))と同じ現象である.

# (4) 第一原理擬ポテンシャルの組み立て法(その2):ポテンシャルの作り替え

さて、擬ポテンシャルの構築は、最外殻のnについてのl =0,1,2等(s,p,d等)の価電子軌道(Al や Si なら 3s(n =2,l=0),3p(n=2,l=1),3d(n=2,l=2))に着目す る.各lの最外殻の価電子軌道毎に、動径方程式(28)におい て、全電子ポテンシャル  $V_{AE}(r)$ を、 $0 \le r \le r_c$ の領域で変形 (底上げ)した擬ポテンシャル  $V_{a,l}(r)$ で置き換え、その領域 の $rR_{nl}(r)$ を解く、下記式(31)のように固有エネルギーは全 電子計算の $\varepsilon_{nl}$ に固定、SCF計算ではなく固定したポテンシ ャル  $V_{a,l}(r)$ の下で $rR_{nl}^{PS}(r)$ をメッシュ点の数値として逐次 法で求める。

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dr^2}rR_{nl}^{\rm PS}(r) + \left\{\frac{\hbar^2l(l+1)}{2mr^2} + V_{a,l}(r)\right\}rR_{nl}^{\rm PS}(r)$$

 $= \varepsilon_{nl} r R_{nl}^{PS}(r), 0 \le r \le r_c$  (31) この式から得られる擬動径波動関数  $R_{nl}^{PS}(r)$ が下記条件を満 たすまで、 $V_{a,l}(r)$ の変形を繰り返し、調整する.  $R_{nl}^{PS}(r)$ の 条件は、①カットオフ半径  $r_c$ 以内の動径波動関数のノルム  $\int_0^r |r R_{nl}^{PS}(r)|^2 dr$ が全電子計算の真の動径波動関数のものと 一致し、② $r_c$ 外で  $R_{nl}^{PS}(r)$ が真の動径波動関数  $R_{nl}(r)$ に一致 し、③正しい固有エネルギー $\varepsilon_{nl}$ を持ち、かつ④ノードを持 たないことである.

図 6(b)にノード二つの 3s 軌道  $rR_{3s}(r) \ge V_{AE}(r)$ から出発 し,条件を満たす  $rR_{3s}^{PS}(r)$ を出力する l = 0(s成分)の  $V_{a,s}(r)$ を構築する様子を示す. $r_c$ 外で正しい全電子ポテン シャルと動径波動関数にスムーズに接続する条件( $V_{a,l}(r) =$  $V_{AE}(r), rR_{nl}^{PS}(r) = rR_{nl}(r)$ )のもと, $0 \le r \le r_c$ で変形(底上げ) した  $V_{a,l}(r)$ が、 $\varepsilon_{nl}$ を固定した式(31)で,条件を満たす  $rR_{nl}^{PS}(r)$ を出力するよう調整する. $V_{a,l}(r)$ の具体的調整法に は多様性がある(後述). Hamannらは, $V_{AE}$ に解析関数を 加え, $0 \le r \le r_c$ でなだらかに底上げし,条件②~④を満たす ようにさせた後,条件①を満たすように $rR_{nl}^{PS}(r)$ の形を調整 し,式(31)の反転で $V_{a,l}(r)$ を再調整している<sup>(26)(27)</sup>. $\varepsilon_{nl}$ の 固定した式(28)(式(31))は, $V_{AE}(r)$ や $V_{a,l}(r)$ のメッシュ点 データに対し $rR_{nl}(r)$ や $rR_{nl}^{PS}(r)$ のデータを出力する方程式 だが,逆に $rR_{nl}(r)$ や $rR_{nl}^{PS}(r)$ のデータが決められる.

最後に  $V_{a,l}(r)$ の下での原子の価電子の擬動径波動関数の 計算から,価電子軌道の電子による遮蔽の効果( $V_H + \mu_{xc}$ )を 求め, $V_{a,l}(r)$ から差し引き(unscreening),(裸の)擬ポテン シャル  $V_{a,l}^{PS}(r)$ を*l*毎に構築する.**図**7に構築した例を示 す.各  $V_{a,l}^{PS}(r)$ は半径  $r_c$ 外では共通にイオン価(原子の価電 子数)を  $Z_a$ として $-e^2 Z_a/r$ である. $r_c$ 外で  $V_{a,l}(r) = V_{AE}(r)$ で, $V_{AE}(r)$ から $Z_a$  個の価電子の  $V_H$ , $\mu_{xc}$  を除去するからで ある. $V_{a,l}^{PS}(r)$ は  $V_{a,l}(r)$ と同様, $r_c$ 内で l(s, p, d 波) 成分毎に形が異なる.screened の  $V_{a,l}(r)$ と unscreening 後の  $V_{a,l}^{PS}(r)$ との区別に注意のこと.裸のポテンシャルとして(価 電子からの  $V_H$ , $\mu_{xc}$  を合わせて)式(26)で用いるのが後者で ある.前者は  $V_{AE}$ を作り変えたそのままのもので,上述の



図7 第一原理擬ポテンシャルの構築例<sup>(26)</sup>. Moの擬ポテン シャル. a.u. は原子単位で, 横軸の距離は1 a.u.  $\approx$ 0.529 Å, 縦軸のエネルギーは1 a.u. = 1Rydberg.  $\approx$  13.6 eV. 上三つのパネルに示すように, 最外殻のs, p, d 軌道(l=0,1,2)について,  $r_c$ 内で原子核近傍の $rR_{nl}(r)$ のノード(破線)を取り除いたスムーズな擬動径波動関 数 $rR_{nl}^{PS}(r)$ (実線)が動径方程式(31)で出力されるように (最下段に示す)s, p, d成分毎の擬ポテンシャル $V_{a,l}^{PS}(r)$ が構築される(unscreening 後のものを示す).

ように原子の動径方程式(28)を $V_{a,l}(r)$ の下で解いて、擬動 径波動関数から価電子密度分布を求め、unscreeningのため の $V_H(r)$ 、 $\mu_{xc}(r)$ を求める.

条件①から,特にノルム保存擬ポテンシャルと呼ばれる. 構築法には多様性がある.上記の $V_{AE}(r)$ の底上げから始める方法以外に,ノードのないスムーズな擬動径波動関数 $R_{nl}^{PS}(r)$ の構築から始めて,式(31)の反転から逆にポテンシャル $V_{a,l}(r)$ を決める方法,ポテンシャルと波動関数の $r_c$ での内と外の接続の仕方を高次微分までスムーズにする工夫など,各種構築法が提案されている<sup>(33)-(35)</sup>.これらは,必要 な平面波基底数を減らすように(第5章(2)節参照)浅くスム ーズな擬ポテンシャルを生む工夫である.また、カットオフ 半径 $r_c$ は、l毎に異なる値 $r_d$ を用いることも行われる.最 外殻の各lの $|rR_{nl}(r)|$ が最大値になる地点 $r_{max}$ と最外のノ ードの間に取られることが多い(図7).

なお、上記の擬ポテンシャル構築の例は、 $r \to \infty$ で波動関 数が収束する( $rR_{nl}(r)$ がゼロになる)「束縛状態」の原子軌 道の作り替えの例であった( $\epsilon_{nl}$ が真の固有エネルギーの場合 に限られる).一方、適当な(固有状態ではない)エネルギー 値  $\epsilon_{nl}$ を式(28)に入れ、 $V_{AE}(r)$ の下で( $r_c$ より大きい)ある距 離まで $rR_{nl}(r)$ を解いて、その $rR_{nl}(r)$ に対し、 $r_c$ 内で上記 条件①~④を満たす擬動径波動関数を生むように式(31)で 擬ポテンシャルを組み立てる方法もある<sup>(33)</sup>.これは、 $r \to \infty$ で $rR_{nl}(r)$ が発散する「非束縛状態」を使って擬ポテンシャ ルを作るやり方である.どちらでも問題はない.

### (5) 擬ポテンシャルの局所項と非局所項

原子毎の擬ポテンシャル  $V_{a,l}^{PS}(r)$ は, $r_c$ 内でl毎に形が異なる(図7).式(5)の  $V(\bar{r})$ の代わりに用いる際には,作用 させる波動関数から原子を中心にしたs波,p波,d波の成 分(l=0,1,2の成分)を(後述のl波への射影演算子を用い て)抜き出し,lの波の成分毎にlの  $V_{a,l}^{PS}(r)$ を作用させる.

ここで、 $r_c$ 内で適当な局所形を持ち、 $r_c$ 外で $-e^2 Z_a/r$ に 接続する共通の局所(local)成分  $V^a_{local}(r)$ を考える(適当な一 つの $l O V^{PS}_{a,l}(r)$ をそのまま  $V^a_{local}(r)$ に選んでも良い).非局 所(non-local)成分を各l毎の  $V^a_{local}(r)$ との差として、

 $\Delta V_{a,l}^{NI}(r) = V_{a,l}^{PS}(r) - V_{local}^{a}(r)$ (32) と定義すると、 $V_{a,l}^{PS}(r)$ は  $r_{c}$ 外で $V_{local}^{a}(r)$ と同じ共通形 $-e^{2}$  $Z_{a}/r$ なので、 $\Delta V_{a,l}^{NL}(r)$ は  $r_{c}$ 内でのみゼロでない. こうして、  $r_{c}$ 内のみで働く非局所ポテンシャル $V_{NL}^{a}(\bar{r})$ として、l波へ の射影演算子  $|l\rangle = \sum_{m=-l}^{+l} |Y_{lm}(\theta, \phi)\rangle$ を用いて、

 $V_{\rm NL}^{a}(\vec{r}) = \sum_{i} |l\rangle \Delta V_{a,l}^{\rm NL}(r) \langle l|$ (33)

が得られる.式(27)の原子毎の $V_a^{\text{PS}}(\bar{r})$ は,全空間で作用する局所項 $V_{\text{local}}^a \ge r_c$ 内のみで働く非局所項 $V_{\text{NL}}^a$ の和になり,次式で表される.

$$V_{a}^{\text{PS}}(\vec{r}) = V_{\text{local}}^{a}(r) + V_{\text{NL}}^{a}(\vec{r}) = V_{\text{local}}^{a}(r) + \sum_{l} |l\rangle \Delta V_{a,l}^{\text{NL}}(r) \langle l|$$

(34)

演算子|1〉の波動関数への作用の詳細は第5章(5)節で説明する.

### (6) 擬ポテンシャルの精度を保証するもの

自由原子の価電子軌道の波動関数やエネルギー準位の条件 で作成された原子毎の擬ポテンシャルを,固体に埋め込んで 使用して,固体中の価電子挙動が高精度に計算できる理由 は,擬ポテンシャルが様々な環境で電子の散乱の性質を正し く保持する transferability を持つからである.

一般に原子やイオンの球対称場の動径方程式(28)の解に

つき, 各*l*毎に以下の恒等式が成り立つ(証明は文献(1)等に ある).

$$\int_{0}^{r_{c}} \{rR_{nl}(\varepsilon_{nl}, r)\}^{2} dr = \left(-\frac{\hbar^{2}}{2m}\right) \{r_{c} R_{nl}(\varepsilon_{nl}, r_{c})\}^{2} \partial D_{nl}(\varepsilon_{nl}, r_{c}) / \partial \varepsilon$$
(35)

 $R_{nl}(\varepsilon, r)$ は式(28)の解の動径波動関数で、式(28)の固有エネ ルギー $\varepsilon$ の関数でもあるとして定義され、 $R_{nl}(\varepsilon_{nl}, r)$ はエネ ルギー $\varepsilon_{nl}$ での解、 $R_{nl}(\varepsilon_{nl}, r_c)$ はその $r_c$ での値、 $D_{nl}(\varepsilon, r)$ は  $R_{nl}(\varepsilon, r)$ のrでの対数微分 $R_{nl}(\varepsilon, r)^{-1}\partial R_{nl}(\varepsilon, r)/\partial r, \partial D_{nl}(\varepsilon_{nl}, r_c)/\partial \varepsilon$ は、その対数微分のエネルギー微分の $\varepsilon_{nl}, r_c$ での値で ある.

式(35)の左辺は動径波動関数の半径 $r_c$ 内のノルムである.右辺の動径波動関数の対数微分 $D_{nl}(\varepsilon, r_c)$ は,球対称ポテンシャル場の $r_c$ での電子の散乱の性質を表す<sup>(1)-(4)</sup>. $\partial D_{nl}(\varepsilon, r_c)/\partial \varepsilon$ は,そのエネルギーに対する変化である.この式は,電子の散乱の性質とそのエネルギー変化は,左辺のノルムが決めるという意味である.

前節までに説明したように、擬動径波動関数  $R_{ns}^{Ns}(r)$ と擬 ポテンシャル  $V_{a,l}(r)$ は、式(28)の動径方程式を満たすの で、式(35)は  $R_{nl}^{PS}(r)$ についても成り立ち、価電子に対する 擬ポテンシャルの散乱の性質に関する式と見なせる. 左辺の ノルムは、 $R_{nl}^{PS}(r)$ の場合も正しい動径波動関数のものと同 じに作られているので、擬ポテンシャルの $r_c$ での散乱の性 質とそのエネルギー変化は、全電子計算の正しいものと同じ である. 従って、ノルム保存擬ポテンシャルは、様々な環境 (原子、分子、固体(結晶、欠陥、表面他))の下、(構築時に 用いた  $\varepsilon_{nl}$ の周りの)一定のエネルギー範囲で、価電子の固 有エネルギーや( $r_c$ 外の)波動関数を正しく出力する. この性 質を擬ポテンシャルの transferability という. こうして、実 験値を用いなくとも、計算のみで様々な物質や構造の電子構 造や全エネルギーの高精度の予測・設計が可能となった.

### (7) ウルトラソフト擬ポテンシャル(USPP)法

ノルム保存擬ポテンシャルは、カットオフ半径  $r_c$ が大き いほど、自由原子の場合の浅い  $V_{AE}$ と接続する条件で作ら れるので、浅くスムーズにできるが、上述のように $r_c$ 内で 波動関数は正しくないので、大きいほど精度が下がる. 一 方、同じ lの軌道が内殻にない 2p 軌道や 3d 軌道が価電子で ある元素(第二周期典型元素、3d 遷移金属等)では、それら の価電子軌道がノードを持たず、原子核近傍に比較的局在す る. こうした価電子についても、原子核近傍の深いポテンシ ャルの効果を回避するためノルム保存擬ポテンシャルが構築 されるが、 $rR_{nl}(r)$ のピークが原子核に近いため、 $r_c$ を小さ くせねばならず、 $r_c$ 内のノルムが原子核近傍に局在する様子 を再現する擬ポテンシャルは必然的に深くなり、平面波基底 展開に不利である.

そこで、ノルム保存擬ポテンシャル構築の条件①~④(本 章(4)節)のうち、ノルム保存条件①を緩和したウルトラソフ ト擬ポテンシャル法(USPP法)<sup>(28)</sup>が開発されている(後述の PAW 法<sup>(29)(30)</sup>でも同様にノルム保存条件を緩和する).条件 ①を緩和すれば、 $r_c$ 外のなだらかなポテンシャルや波動関数 の延長を $r_c$ 内にも想定でき、必要な平面波基底数が大きく 減らせる(後述の $E_{cut}$ が大きく減らせる(第5章(2)節)).し かし、ノルム保存条件がなければ、式(35)の擬ポテンシャ ルの transferability に問題が生じる.そこで、波動関数を決 める Kohn–Sham 方程式や波動関数の規格化、電子密度や全 エネルギーの計算の各過程で、 $r_c$ 内の不足分のノルムを補償 電荷として自動的に付加する仕組みである(PAW 法も同 様).なお、補償電荷と非局所擬ポテンシャルの扱いには、 次節で触れる projector を用いる.

# (8) PAW法

USPP 法においても r<sub>c</sub>内の価電子波動関数の形はノード が除かれ,正しくない.物質の通常の性質は,価電子波動関 数の原子間領域の振る舞いが決定するので問題は生じない. しかし,磁性など,原子核近傍の波動関数挙動が鍵を握る物 性の計算では精度が落ち,FLAPW 法など計算負荷の大き な全電子法(線形化法,本章(1)節の③の分類)を用いざるをえ ない.そこで,擬ポテンシャル法の効率性と全電子法の精度 を併せ持つ方法として,PAW法が開発された<sup>(29)(30)</sup>.

この方法では、原子核近傍でノードを持たない擬波動関数 を扱いながら、全エネルギーやハミルトニアンの表式では、 各原子の半径 r<sub>c</sub>の球内の部分をノードを持つ正しい価電子 波動関数の表現(図5(a)参照)に置き換えて扱う.そのた め、平面波基底での変分計算(固有状態計算)は従来の擬ポテ ンシャル法と同様、比較的少ない平面波の展開で効率的に行 いながら、結果的に原子核近傍でノードを持つ正しい価電子 波動関数やそれに基づく全エネルギーが高精度に得られる.

具体的には、PAW 法では、固体中の価電子の波動関数に ついて、まず、式(32)の  $V_{local}^{a}$ に価電子分布からの  $V_{H}$ ,  $\mu_{xc}$ を加えたポテンシャルの下、各原子の $r_{c}$ 内でノードを持た ず、 $r_{c}$ 外の原子間領域で正しい波動関数になるように、従来 法と同様の平面波基底展開による擬波動関数  $\phi_{hn}^{PS}(\bar{r})$ を扱う (例えば、次章の式(43)).一方、各原子の $r_{c}$ 球内部分の $\phi_{hn}^{PS}(\bar{r})$ を組み立て る<sup>(29)(30)</sup>.

$$\psi_{\bar{k}n}(\bar{r}) = \psi_{\bar{k}n}^{\mathrm{PS}}(\bar{r}) + \sum (|\phi_i\rangle - |\tilde{\phi}_i\rangle) \langle \tilde{p}_i | \psi_{\bar{k}n}^{\mathrm{PS}}(\bar{r})$$
(36)

右辺第二項が $r_c$ 球内の作り替えの操作で,iの和は各原子の 価電子の $i = (l, m, \tau)$ で取られる. $|\phi_i\rangle$ , $|\tilde{\phi_i}\rangle$ , $|\tilde{p_i}\rangle$ は各原子 位置を中心とする原子軌道様の関数(または演算子)で,各元 素で価電子軌道のl毎に各々二つ( $\tau = 1, 2$ )用意される.

 $|\phi_i\rangle$ は $r_c$ 球内の正しい電子構造を表現する展開基底 AE (all-electron)partial wave(全電子部分波)で、本章(3)節の自 由原子の全電子計算からの動径波動関数 $R_{nl,\tau}(r)$ と球面調和 関数 $Y_{lm}(\theta,\phi)$ の積である. $R_{nl,\tau}(r)$ は、式(28)で既に求めた 原子の全電子ポテンシャル $V_{AE}(r)$ に固定し、各lで、異な った二つのエネルギー準位 $\varepsilon_{nl,\tau}(\tau=1, 2, 固有状態のものと$  $励起したエネルギーのもの)で各々解いて求める (<math>R_{nl,\tau=1}$ (r), $R_{nl,\tau=2}(r)$ ).内殻軌道と直交し、ノードを持つ. 一方,各AE partial に対応した PS (pseudo) partial wave (擬部分波)  $|\tilde{\phi}_i\rangle$ のセットも用意する. $|\tilde{\phi}_i\rangle$ は, $r_c$ 外で各々  $|\phi_i\rangle$ の $R_{nl,\tau}(r)$ に滑らかに接続し, $r_c$ 内でノードを持たずス ムーズに変化する擬動径波動関数( $R_{nl,\tau=1}^{PS}(r)$ ,  $R_{nl,\tau=2}^{PS}(r)$ ) を適当に組みたて, $Y_{lm}(\theta, \phi)$ を掛けた形である(USPP 法と 同様にノルム保存条件は課さなくてよい).

各 | $\tilde{\phi}_i$ 〉に対応する projector | $\tilde{p}_i$ 〉も動径関数  $P_{nl,\tau}(r)$ に  $Y_{lm}(\theta, \phi)$ を掛けた形である.  $P_{nl,\tau}(r)$ は以下のように組み立 てる. 各 lで,  $r_c$ 内で底上げし,  $r_c$ 以遠で  $V_{AE}(r)$ に接続す る局所ポテンシャル  $V_{local}(r)$  (上述の  $V_{aca}^a$ に価電子分布の  $V_H$ ,  $\mu_{xc}$ を加えたもの)のもと,式(31)に AE partial の場合 と同じ二つの参照エネルギー  $\varepsilon_{nl,\tau}$  と作成済の上記  $R_{nl,\tau}^{PS}(r)$ を 各々代入し,次式のように右辺と左辺の差をとれば,二種( $\tau$ = 1,2)の動径関数  $P_{nl,\tau}(r) = \Delta V_{l,\tau}(r) R_{nl,\tau}^{PS}(r)$ が $r_c$ 内のメッ シュ点で得られる( $\Delta V_{l,\tau}(r) r R_{nl,\tau}^{PS}(r)$ のデータをrで割る).

$$\Delta V_{l,\tau}(r) r R_{nl,\tau}^{\rm PS}(r) = \varepsilon_{nl,\tau} r R_{nl,\tau}^{\rm PS}(r) - \left[ -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dr^2} r R_{nl,\tau}^{\rm PS}(r) + \left\{ \frac{\hbar^2 l(l+1)}{2mr^2} + V_{\rm local}(r) \right\} r R_{nl,\tau}^{\rm PS}(r) \right]$$
(37)

 $\Delta V_{l,\tau}(r)$ は式(32)の $\Delta V_{a,l}^{\text{NL}}(r)$ と同様の非局所擬ポテンシャ ルの意味を持つ( $r_c$ 外でゼロ). この $\tau$ =1,2の二種の動径関 数 $P_{nl,\tau}(r)$ の各々に $Y_{lm}(\theta, \phi)$ を掛けた二種の演算子の間で,  $\langle \tilde{p}_i | \tilde{\phi}_j \rangle = \langle \tilde{\phi}_i | \tilde{p}_j \rangle = \delta_{ij}$ を満たすように動径関数部分を作り替 え(dual 化, *i*, *j*は *lm* が共通で $\tau$ が異なる2×2の間でと る),  $| \tilde{p}_i \rangle$ のセットが構築される<sup>(28)-(30)</sup>.

ノルム保存擬ポテンシャルの場合,一つの参照エネルギー  $\varepsilon_{nl} \varepsilon W_{o}ch, PAW 法は二つの参照エネルギー \varepsilon_{nl,\tau}(\tau=1, 2) を扱うので,より高精度になる. <math>|\tilde{\phi}_i\rangle$ は $r_c$ 外では AE partial  $|\phi_i\rangle$ に一致するので,式(36)の $|\phi_i\rangle - |\tilde{\phi}_i\rangle$ は $r_c$ 外で消え る( $|\tilde{p}_i\rangle$ も各原子の $r_c$ 内のみに作用する).  $|\phi_i\rangle \geq |\tilde{\phi}_i\rangle$ の動径 関数は, $r_c$ を超える部分まで用意すればよい(上述のように 「非束縛状態」のものでもよい).式(36)の $|\tilde{p}_i\rangle$ で $\phi_{En}^{FS}(\bar{r})$ を  $|\tilde{\phi}_i\rangle$ 成分に射影することで,展開係数 $c_i = \langle \tilde{p}_i | \phi_{En}^{PS}(\bar{r}) = \int \tilde{p}_i^*(\bar{r}) \phi_{En}^{PS}(\bar{r}) d\bar{r}$ (積分は $r_c$ 球内)を通じて $r_c$ 球内を PS par-

tial の展開 $\sum_{c_i} \tilde{\phi}_i(\bar{r})$ で表現する. これを $\phi_{\ell m}^{PS}(\bar{r})$ から差し引

き, ノードを持つ AE partial での展開  $\sum_{i} c_i \phi_i(\bar{r})$  で入れ替え るわけである.

全エネルギーやハミルトニアンでは、この入れ替えた形に 対応して、原子球内のノードを持つ軌道部分の運動エネルギ ー、ポテンシャルエネルギーも正確に扱う.変分計算(固有 状態計算)で直接に扱うのは、従来の擬ポテンシャル法と同 様、スムーズな $\phi_{kn}^{PS}(\vec{r})$ の平面波基底展開の係数部分(後述の 式(43)の $\{C_{k+c}^n\}$ )なので、計算負荷は従来法と大きくは変わ らないが、上記  $c_i$ にも $\{C_{k+c}^n\}$ が含まれ、事実上、式(36)の 真の価電子波動関数の最適化を通じた全エネルギー式(1) の最小化が行われる.実際には、USPP 法と同様に補償電 荷の問題も加わるので複雑だが、波動関数も全エネルギーも、  $r_c$ 球の内外で高精度に得られる. なお、上述の projector  $|\tilde{p}_i\rangle$ は、第5章(5)節で扱う分離形 非局所擬ポテンシャル<sup>(36)</sup>の構成要素でもあり、USPP 法や PAW 法での非局所擬ポテンシャルや(ノルム保存条件の緩 和による)補償電荷の取り扱いで多用される.詳細は文献 (28)-(30)(37)などを参照されたい.

PAW 法は、従来の擬ポテンシャル法と比べて、かなり様 子の異なる手法であるが、PSとAEの partial wave や projector、V<sub>local</sub>の構築、全エネルギー、ハミルトニアンの 組み立てなど、擬ポテンシャル法と共通の概念の下に開発さ れており、計算技術の発展と捉えることができる.なお、本 講義ノートでは論じないが、PAW 法には Transformation theory など別の側面もある<sup>(29)(30)</sup>.より詳しいノート<sup>(38)</sup>を 希望の方は連絡されたい.

ノルム保存擬ポテンシャル法,USPP法,PAW法の一連 の平面波基底の第一原理計算法の精度,信頼性を保証するも のは,各元素の自由原子の全電子軌道計算に基づくr<sub>c</sub>の原 子球内外の価電子挙動の扱いであると言える.自由原子の計 算は,球対称場なので,変数分離で一次元の動径方程式で容 易に実行され,systematicに擬ポテンシャルや partial wave, projector等が構築できる.なお,多くの汎用コード では,各元素の擬ポテンシャルや PAW 法用の partial wave, projector等がデータベースで用意されており,ユー ザーが自由原子の計算から始める必要はない.

# 文 献

- (23) S. Ono, Y. Noguchi, R. Sahara, Y. Kawazoe and K. Ohno: Comput. Phys. Commun., 189 (2015), 20–30.
- (24) O. K. Andersen: Phys. Rev. B, 12(1975), 3060-3083.

- (25) K. Schwarz and P. Blaha: Lecture Notes in Chemistry, 67 (1996), 139–153.
- (26) D. R. Hamann, M. Schlüter and C. Chiang: Phys. Rev. Lett., 43 (1979), 1494–1497.
- (27) G. B. Bachelet, D. R. Hamann, and M. Schlüter: Phys. Rev. B, 26 (1982), 4199–4228.
- (28) D. Vanderbilt: Phys. Rev. B, 41(1990), 7892–7895.
- (29) P. E. Blöchl: Phys. Rev. B, **50**(1994), 17953–17979.
- (30) G. Kresse and D. Joubert: Phys. Rev. B, 59(1999), 1758–1775.
- (31) J. C. スレーター:スレーター分子軌道計算,東京大学出版 会,(1982).
- (32) 和光信也:コンピュータで見る固体の中の電子-バンド計算の 基礎と応用,講談社,(1992).
- (33) D. R. Hamann: Phys. Rev. B, 40(1989), 2980–2987.
- (34) A. M. Rappe, K. M. Rabe, E. Kaxiras and J. D. Joannopoulos: Phys. Rev. B, 41 (1990), 1227–1230.
- (35) N. Troullier and J. L. Martins: Phys. Rev. B, 43(1991), 1993– 2006.
- (36) L. Kleinman and D.M. Bylander: Phys. Rev. Lett., 48(1982), 1425–1428.

攻)博士課程中退

- (37) P. E. Blöchl: Phys. Rev. B, 41(1990), 5414-5416.
- (38) 香山正憲: PAW ノート Ver. 1.7, (2011).

(全ての文献番号は、第一回からの通しとなっております) (次号へつづく)

\*\*\*\*\*\*

1985年 東京大学大学院工学系研究科(金属材料学専



香山正憲

同年 工業技術院 大阪工業技術試験所(現産業技 術総合研究所関西センター)入所 2004年 産業技術総合研究所 ユビキタスエネルギー

研究部門 グループ長 2015年 産業技術総合研究所 エネルギー・環境領域

電池技術研究部門 首席研究員 2021年~現職

専門:計算材料科学,粒界・界面・ナノ構造の材料科 学,新規手法・コードの開発

Modelling and Simulation in Materials Science and Engineering誌 Editorial Board member E-mail: m-kohyama@aist.go.jp

\*\*\*\*\*